## Tn準位を考慮した4準位モデルによる熱活性化遅延蛍光材料の評価

Analysis of PL properties of thermally activated delayed fluorescence emitters based on a four-level model considering T<sub>n</sub> state

<sup>O</sup>川手 大輔<sup>1</sup>, 長谷山 翔太<sup>1</sup>, 丹羽 顕嗣<sup>1</sup>, 小林 隆史<sup>1,2</sup>, 永瀬 隆<sup>1,2</sup>, 合志 憲一<sup>3,4</sup>, 安達 千波矢<sup>3,4</sup>, 内藤 裕義<sup>1,2</sup>

(1. 大阪府大工, 2. 大阪府大 RIMED, 3. 九大 OPERA, 4. 九大 JST-ERATO 安達分子エキシトン工学プロジェクト)

<sup>O</sup>D. Kawate<sup>1</sup>, S. Haseyama<sup>1</sup>, A. Niwa<sup>1</sup>, T. Kobayashi<sup>1,2</sup>, T. Nagase<sup>1,2</sup>, K. Goushi<sup>3,4</sup>, C. Adachi<sup>3,4</sup>, H. Naito<sup>1,2</sup>

(1. Osaka Pref. Univ., 2. RIMED, 3. OPERA, Kyushu Univ., 4. JST-ERATO, Kyushu Univ.)

E-mail: daisuke.kawate.oe@pe.osakafu-u.ac.jp

**はじめに** 熱活性化遅延蛍光(TADF)材料の 発光緩和過程に、 $S_1 \ge T_1$ 以外の励起状態が関 与していることがいくつかの研究グループか ら指摘されている。我々も高次三重項励起状態 (以下  $T_n \ge$ 略す)を考慮した4準位モデルに より、1,2,3,5-tetrakis(carbazol-9-yl)-4,6-dicyano benzene (4CzIPN)の発光寿命の温度依存性が広 い範囲で説明でき、さらに  $T_n$ からの燐光が 100K 付近でのみ観測できることなどを報告し てきた[1,2]。本研究では、4CzIPN を含む4種 類のカルバゾールジシアノベンゼン系 TADF 材料について同様の手法で評価を行い、分子構 造の違いが緩和過程に及ぼす影響について調 べたので、その結果について報告する。

実験 TADF 材料には、緑色発光を示す 4CzIPN に加え、スカイブルー発光を示す 1,2-bis (carbazol-9-yl)-4,5-dicyanobenzene (2CzPN)、黄 色発光を示す 1,2,4,5tetrakis(carbazol-9-yl) -3,6-dicyanobenzene (4CzTPN)、さらに赤色発光 を示す 1,4-dicyano-2,3,5,6-tetrakis(3,6-diphenyl carbazol-9-yl)benzene (4CzTPN-Ph)を用いた。そ れらの化学構造式を図 1(a)に示す。ホスト材料 には1,3-bis(9-carbazolyl)benzene (mCP)を用い、 それぞれ 5 wt%のドープ膜をスピンコート法 により作製した。緩和速度については、励起光 源に Nd:YAG レーザー(355 nm)の三倍波を 用いてフォトンカウンティング法により発光 減衰曲線を取得し、最も遅く緩和する成分に注 目して見積もった。発光量子収率(PLQE)は He-Cd レーザー (325 nm) を励起光源とし、積 分球を用いて測定した。

**結果および考察** 得られた緩和速度の温度依存性を Fig. 1(b)に示す。室温付近の値は主に遅延蛍光の緩和速度に対応し、極低温領域の値は燐光の緩和速度に対応する。図中の実線は、 $T_n$ 準位を考慮した4準位モデルによるフィッティング結果であり、全体として実験結果を良く再現できていることが分かる。このフィッティングにより、 $T_1 \ge S_1$ のギャップ( $\Delta E T_1 \cdot T_2$ )および $T_1 \ge T_n$ のギャップ( $\Delta E T_1 \cdot T_2$ )を±10 meV程度の精度で推定することができる。得られた結果をTable 1 にまとめる。この結果より、4CzTPN および 4CzTPN-Ph は発光ピーク波長

が 50 nm も離れているにも関わらず、 $\Delta E_{T_i \cdot S_i}$ は同程度であることが分かる。また PLQE は必ずしも $\Delta E_{T_i \cdot S_i}$ のみでは決まっていないことが分かる。さらに 2CzPN では、 $\Delta E_{T_i \cdot S_i}$ が大きすぎるため、室温での発光に  $T_n$ からの燐光が混合している可能性があることも分かった。



Fig. 1 (a) Chemical structures of TADF emitters used in this study. (b) Temperature dependence of the lowest PL decay rate of 2CzPN, 4CzIPN, 4CzTPN and 4CzTPN-Ph doped m-CP thin films. The solid lines represent the results calculated with a four-level model considering  $T_n$ . (c) Four-level model.

Table 1 Energy gaps obtained from the fits and measured PLQE.

	$\Delta E \operatorname{T_1-S_1}(\mathrm{meV})$	$\Delta E \operatorname{T_1-T_n}(\mathrm{meV})$	PLQE (%)
2CzPN	230	150	68
4CzIPN	140	40	71
4CzTPN	90	30	67
4CzTPN-Ph	90	30	15

**謝辞** 本研究の一部は、新学術領域研究「元素 ブロック高分子材料の創出」の助成を受けた。 参考文献 [1] 高木他,第20回有機 EL 討論会 S5-3, (2015). [2] 長谷山他,第62回応用物理学 会春季学術講演会 20p-W512-12, (2016).